

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4624763号
(P4624763)

(45) 発行日 平成23年2月2日(2011.2.2)

(24) 登録日 平成22年11月12日(2010.11.12)

(51) Int.CI.

F 1

A61B 8/00 (2006.01)
H04R 19/00 (2006.01)A61B 8/00
H04R 19/00 330

請求項の数 19 (全 23 頁)

(21) 出願番号 特願2004-312172 (P2004-312172)
 (22) 出願日 平成16年10月27日 (2004.10.27)
 (65) 公開番号 特開2006-122188 (P2006-122188A)
 (43) 公開日 平成18年5月18日 (2006.5.18)
 審査請求日 平成19年6月25日 (2007.6.25)

(73) 特許権者 000000376
 オリンパス株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
 (74) 代理人 100074099
 弁理士 大菅 義之
 (72) 発明者 若林 勝裕
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパス株式会社内
 (72) 発明者 安達 日出夫
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパス株式会社内
 (72) 発明者 根本 清志
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパス株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 静電容量型超音波振動子、及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコン基板と、該シリコン基板の上面に配設された第1の電極と該第1の電極と対向し所定の空隙を隔てて配設された第2の電極と該第2の電極を支持するメンブレンとからなる振動子セルから構成された振動子エレメントと、を含む静電容量型超音波振動子において、

隣接する前記振動子エレメント間に溝部を設け、さらに、

前記シリコン基板を貫通するスルーホール電極部と、

前記溝部に形成され、前記第2の電極と電気的に接続される導電膜と、

前記シリコン基板の背面に形成され、接地配線と接続される電極パッドと、を含み、

前記導電膜は、前記シリコン基板に形成されたオーミックコンタクト領域を介して、前記電極パッドと電気的に接続され、

前記第1の電極は、前記スルーホール電極部と電気的に接続されていることを特徴とする静電容量型超音波振動子。

【請求項 2】

さらに、前記シリコン基板の前記背面に前記電極パッドを介して接合され、前記接地配線が配設されるフレキシブルプリント基板を含むことを特徴とする請求項1に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 3】

一次元に複数配列された前記振動子エレメントから構成される振動子ユニット間に設け

10

20

られた前記溝部の底部は、前記シリコン基板と前記電極パッドを貫通して前記フレキシブルプリント基板の表面に達していることを特徴とする請求項 2 に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 4】

前記導電膜は、前記溝部の溝内壁部及び底部に形成され、前記第 2 の電極に接することを特徴とする請求項 1 ~ 3 のうちいずれか 1 項に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 5】

前記溝部は、超音波減衰材料で充填されていることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のうちいずれか 1 項に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 6】

前記超音波減衰材料が、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、及びウレタン樹脂のうち少なくともいずれか 1 つを主成分とする樹脂にタングステン微粉末を混合した複合樹脂であることを特徴とする請求項 5 に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 7】

前記溝部の断面形状は、該溝部の底部に向かうに従い溝幅が小さくなるテーパー形状であることを特徴とする請求項 1 に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 8】

前記溝部の内壁にサブ μ m オーダー以上の凹凸を設けたことを特徴とする請求項 1 ~ 7 のうちいずれか 1 項に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 9】

前記貫通された溝表面は該表面を前記導電膜により被膜されており、該溝表面は前記フレキシブルプリント基板に配設された前記接地配線に導電性接着剤、ボールバンプまたは異方性導電体シートを介して接続されていることを特徴とする請求項 3 に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 10】

前記溝部は、前記振動子エレメントを上方から見た場合に、少なくとも直線形状以外の、曲線形状、または鋸線形状を有することを特徴とする請求項 1 ~ 9 のうちいずれか 1 項に記載の静電容量型超音波振動子。

【請求項 11】

シリコン基板と、該シリコン基板を貫通するスルーホール電極部と、該シリコン基板の上面に配設され前記スルーホール電極部と電気的に接続された第 1 の電極と該第 1 の電極と対向し所定の空隙を隔てて配設された第 2 の電極と該第 2 の電極を支持するメンブレンとからなる振動子セルから構成される振動子エレメントと、前記シリコン基板の背面に形成され接地配線と接続された電極パッドと、前記接地配線が配設され前記電極パッドを介して前記シリコン基板の背面に接合されたフレキシブルプリント基板と、を含む静電容量型超音波振動子の製造方法において、

隣接する前記振動子エレメント間に溝部を設ける溝形成工程と、

前記溝部に前記第 2 の電極と電気的に接続される第 3 の電極を形成する導電化工程と、含み、

前記導電化工程は、前記シリコン基板に、前記電極パッドと前記第 3 の電極とを電気的に接続するオーミックコンタクト領域を形成するコンタクト領域形成工程と、を含むことを特徴とする静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項 12】

前記導電化工程では、イオン注入または化学気相成長方法を行った後に、拡散処理を行うことにより前記第 3 の電極を形成することを特徴とする請求項 11 に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項 13】

前記導電化工程では、物理気相成長法により前記第 3 の電極を形成することを特徴とする請求項 11 に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項 14】

10

20

30

40

50

さらに、前記第3の電極を形成した前記溝部に超音波減衰材料を充填する超音波減衰材料充填工程を含むことを特徴とする請求項11～13のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項15】

さらに、前記超音波減衰材料を充填した前記溝部を裁断する第1の裁断工程を含むことを特徴とする請求項14に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項16】

前記シリコン基板と前記電極パッドを貫通して前記フレキシブルプリント基板の表面に達するまで、前記溝部を裁断する第2の裁断工程を含むことを特徴とする請求項11～15のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。 10

【請求項17】

前記第1の裁断工程は、レーザービームを用いて裁断することを特徴とする請求項15に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項18】

前記第2の裁断工程は、レーザービームを用いて裁断することを特徴とする請求項16に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法。

【請求項19】

請求項1～10のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子を備えることを特徴とする超音波内視鏡。

【発明の詳細な説明】 20

【技術分野】

【0001】

本発明は、シリコンマイクロマシーニング技術を用いてシリコン半導体基板を加工した静電容量型超音波振動子に関する。

【背景技術】

【0002】

体腔内に超音波を照射し、そのエコー信号から体内の状態を画像化して診断する体腔内超音波診断装置による超音波診断法が普及している。この超音波診断法に用いられる機材の1つに超音波内視鏡がある。超音波内視鏡は、体腔内へ挿入する挿入部の先端に超音波振動子（超音波トランスデューサ）が取り付けてあり、このトランスデューサは電気信号を超音波に変換し体腔内へ照射したり、また体腔内で反射した超音波を受信して電気信号に変換したりするものである。 30

【0003】

従来、超音波トランスデューサでは、電気信号を超音波に変換させる圧電素子として、セラミック圧電材PZT（ジルコン酸チタン酸鉛）が使用されてきたが、シリコンマイクロマシーニング技術を用いてシリコン半導体基板を加工した静電容量型超音波トランスデューサ（Capacitive Micro machined Ultrasonic Transducer（以下、c-MUTと称する））が注目を集めている（例えば、非特許文献1）。これは、マイクロマシン（MEMS：Micro Electro - Mechanical System、超小型電気的・機械的複合体）と総称される素子の1つである。 40

【0004】

MEMS素子は、シリコン基板、ガラス基板等の基板上に微細構造体として形成されており、機械的駆動力を出力する駆動体と、駆動体を駆動する駆動機構と、駆動機構を制御する半導体集積回路等とを電気的に、更には機械的に結合させた素子である。MEMS素子の基本的な特徴は、機械的構造として構成されている駆動体が素子の一部に組み込まれていることであって、駆動体の駆動は、電極間のクーロン引力などを応用して電気的に行われる。

【0005】

さて、非特許文献1では、図15に示すようなc-MUTが開示されている。図15（

50

a) は 6 4 個の振動子エレメントからなる 1 次元 c - M U T アレイの 2 セットを上面から観た図を示しており、図 15 (b) はダミーネイバー (D u m m y N e i g h b o r) を設けた単離された 1 個の c - M U T エレメントを示しており、図 15 (c) は並列に接続された 8×160 個のセルで構成された c - M U T エレメントの拡大図を示す。ここで、振動子エレメントとは駆動制御信号を入出力する最小単位である。この振動子エレメントは複数の振動子セルから構成されている。

【 0 0 0 6 】

振動子エレメント 5 0 0 は、複数のセル 5 0 1、各セル 5 0 1 の上部に設けられた上部電極 5 0 2、接地電極 5 0 3、ダミーネイバー (D u m m y N e i g h b o r) 5 0 5 、溝 (トレンチ) 部 5 0 6 から構成されている。隣接する上部電極 5 0 2 間は導通しており、さらに両端の接地電極 5 0 3 に接続されている。ダミーネイバー 5 0 5 は、隣接するエレメントとのクロストークを防止するためのものである。電極 5 0 2 , 5 0 3 とダミーネイバーの間には、溝 5 0 6 が設けてある。

【 0 0 0 7 】

上部電極 5 0 2 は、メンブレンにより支持されている。また、不図示ではあるが、上部電極 5 0 2 と対向する位置でセル内部に下部電極が設けられ、下部電極とメンブレン間に空隙部 (キャビティ) がある。振動子エレメント 5 0 0 の上部電極 5 0 2 及び下部電極に電圧を印加すると、各セル 5 0 1 が同時に駆動して、同位相で一斉に振動する。これにより、超音波が放射される。

【 0 0 0 8 】

非特許文献 1 では、シリコン基板のラム (L a m b) 波 (A 0 モード) 及び固相 - 液相間のストンリー (S t o n e l e y) 波 (境界波) が隣接する振動子エレメント間のクロストークに重大な影響を与えることを見出しており、振動子エレメント 5 0 0 を用いることによりその影響を軽減している。

【非特許文献 1】 Xuecheng Jin , 外 3 名、 「 C h a r a c t e r i z a t i o n o f O n e - D i m e n s i o n a l C a p a c i t i v e M i c r o m a c h i n e d U l t r a s o n i c I m m e r s i o n T r a n s d u c e r A r r a y s 」 , “ I E E E T R A N S A C T I O N S O N U L T R A S O N I C S , F E R R O E L E C T R I C S , A N D F R E Q U E N C Y C O N T R O L ” , V O L . 4 8 , N O . 3 , P 7 5 0 - 7 6 0 , M A Y 2 0 0 1

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 9 】

しかしながら、振動子エレメント 5 0 0 のように、溝部 5 0 6 と、ダミーネイバー領域 5 0 5 と、溝部 5 0 6 と超音波を送受するセル領域の間に電極領域 5 0 3 とを設けると、振動子エレメント全体に占める振動子セル領域の比率が小さくなる。

【 0 0 1 0 】

この場合に、セル領域の面積をある程度の大きさに保持しようとすると、振動子エレメントを大きくする必要があり、この c - M U T を使用した超音波振動子の小型化を図ることができない。また、エレメントの大きさを従来と同程度に保持しようとすると、セル領域の面積を小さくする必要があり、発生させる超音波の出力低下を招くことになる。

【 0 0 1 1 】

上記の課題に鑑み、本発明では、振動子エレメントの両端に溝部を設けた静電容量型超音波振動子において、全体に占めるセル領域の面積比率を低下させず、かつ発生させる超音波の出力低下のない静電容量型超音波振動子を提供する。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 1 2 】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項 1 に記載の発明によれば、シリコン基板と、該シリコン基板の上面に配設された第 1 の電極と該第 1 の電極と対向し所定の空隙を隔てて配設された第 2 の電極と該第 2 の電極を支持するメンブレンとからなる振動子セルから構成

10

20

30

40

50

された振動子エレメントと、を含む静電容量型超音波振動子において、隣接する前記振動子エレメント間に溝部を設け、さらに、前記シリコン基板を貫通するスルーホール電極部と、前記溝部に形成され、前記第2の電極と電気的に接続される導電膜と、前記シリコン基板の背面に形成され、接地配線と接続される電極パッドと、を含み、前記導電膜は、前記シリコン基板に形成されたオーミックコンタクト領域を介して、前記電極パッドと電気的に接続され、前記第1の電極は、前記スルーホール電極部と電気的に接続されていることを特徴とする静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。

【0013】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項2に記載の発明によれば、さらに、前記シリコン基板の前記背面に前記電極パッドを介して接合され、前記接地配線が配設されるフレキシブルプリント基板を含むことを特徴とする請求項1に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。10

【0014】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項3に記載の発明によれば、一次元に複数配列された前記振動子エレメントから構成される振動子ユニット間に設けられた前記溝部の底部は、前記シリコン基板と前記電極パッドを貫通して前記フレキシブルプリント基板の表面に達していることを特徴とする請求項2に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。

【0015】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項4に記載の発明によれば、前記導電膜は、前記溝部の溝内壁部及び底部に形成され、前記第2の電極に接することを特徴とする請求項1～3のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。20

【0016】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項5に記載の発明によれば、前記溝部は、超音波減衰材料で充填されていることを特徴とする請求項1～4のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。

【0017】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項6に記載の発明によれば、前記超音波減衰材料が、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、及びウレタン樹脂のうち少なくともいずれか1つを主成分とする樹脂にタンクステン微粉末を混合した複合樹脂であることを特徴とする請求項5に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。30

【0018】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項7に記載の発明によれば、前記溝部の断面形状は、該溝部の底部に向かうに従い溝幅が小さくなるテーパー形状であることを特徴とする請求項1に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。

【0019】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項8に記載の発明によれば、前記溝部の内壁にサブμmオーダー以上の凹凸を設けたことを特徴とする請求項1～7のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。40

【0020】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項9に記載の発明によれば、前記貫通された溝表面は該表面を前記導電膜により被膜されており、該溝表面は前記フレキシブルプリント基板に配設された前記接地配線に導電性接着剤、ボールバンプまたは異方性導電体シートを介して接続されていることを特徴とする請求項3に記載の静電容量型超音波振動子を提供することによって達成できる。

【0021】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項10に記載の発明によれば、前記溝部は、前記振動子エレメントを上方から見た場合に、少なくとも直線形状以外の、曲線形状、または鋸線形状を有することを特徴とする請求項1～9のうちいずれか1項に記載の静電容量型超50

音波振動子を提供することによって達成できる。

【0022】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項11に記載の発明によれば、シリコン基板と、該シリコン基板を貫通するスルーホール電極部と、該シリコン基板の上面に配設され前記スルーホール電極部と電気的に接続された第1の電極と該第1の電極と対向し所定の空隙を隔てて配設された第2の電極と該第2の電極を支持するメンブレンとからなる振動子セルから構成される振動子エレメントと、前記シリコン基板の背面に形成され接地配線と接続された電極パッドと、前記接地配線が配設され前記電極パッドを介して前記シリコン基板の背面に接合されたフレキシブルプリント基板と、を含む静電容量型超音波振動子の製造方法において、隣接する前記振動子エレメント間に溝部を設ける溝形成工程と、前記溝部に前記第2の電極と電気的に接続される第3の電極を形成する導電化工程と、を含み、前記導電化工程は、前記シリコン基板に、前記電極パッドと前記第3の電極とを電気的に接続するオーミックコンタクト領域を形成するコンタクト領域形成工程と、を含むことを特徴とする静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。10

【0023】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項12に記載の発明によれば、前記導電化工程では、イオン注入または化学気相成長方法を行った後に、拡散処理を行うことにより前記第3の電極を形成することを特徴とする請求項11に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。

【0024】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項13に記載の発明によれば、前記導電化工程では、物理気相成長法により前記第3の電極を形成することを特徴とする請求項11に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。20

【0025】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項14に記載の発明によれば、さらに、前記第3の電極を形成した前記溝部に超音波減衰材料を充填する超音波減衰材料充填工程を含むことを特徴とする請求項11～13のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。

【0026】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項15に記載の発明によれば、さらに、前記超音波減衰材料を充填した前記溝部を裁断する第1の裁断工程を含むことを特徴とする請求項14に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。30

【0027】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項16に記載の発明によれば、前記シリコン基板と前記電極パッドを貫通して前記フレキシブルプリント基板の表面に達するまで、前記溝部を裁断する第2の裁断工程を含むことを特徴とする請求項11～15のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。

【0028】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項17に記載の発明によれば、前記第1の裁断工程は、レーザービームを用いて裁断することを特徴とする請求項15に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。40

【0029】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項18に記載の発明によれば、前記第2の裁断工程は、レーザービームを用いて裁断することを特徴とする請求項16に記載の静電容量型超音波振動子の製造方法を提供することによって達成できる。

【0030】

上記課題は、特許請求の範囲の請求項19に記載の発明によれば、請求項1～10のうちいずれか1項に記載の静電容量型超音波振動子を備えることを特徴とする超音波内視鏡を提供することによって達成できる。

【発明の効果】

10

20

30

40

50

【0031】

本発明を用いることにより、エレメントの両端に溝を設けた静電容量型超音波振動子において、全体に占めるセル領域の面積比率を低下させる必要がなくなる。それにより、発生させる超音波の出力が軽減することが無くなる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0032】**

<第1の実施形態>

本実施形態では、溝部の底部に接地電極を設けた振動子エレメントの製造について説明する。

【0033】

10

図1は、本実施形態における静電容量型ラジアル走査アレイ超音波振動子を示す。静電容量型ラジアル走査アレイ超音波振動子1は、複数の振動子エレメント3から構成される振動子ユニット2、制御回路ユニット4、配線用FPC(フレキシブルプリント基板)5から構成される。

【0034】

複数の長方形状の振動子ユニット2は短手方向に直列に結合し、それが円筒形をなしている。配線用FPC5は、FPC上に配線パターンや電極パッドが形成されているものである。制御回路ユニット4はFPC5に対しCMUTとは反対の面に振動子ユニット2と位置をあわせて、1振動子ユニットに1制御回路ユニットという配置になっている。CMUTのエレメントを単位としてFPCを貫通するスルーホールが形成され、それを通してCMUTユニットと制御回路ユニットが接続される様に配置される。制御回路ユニット4はパルサー、チャージアンプ、マルチプレクサ等の集積回路等から構成される。なお、振動子ユニット2の形状は長方形に限定されない。

20

【0035】

図2は、本実施形態における振動子ユニット2単体の上面図を示す。振動子ユニット2は、複数の正方形状の振動子エレメント3から構成されている。同図では、振動子ユニット2は振動子エレメント3を複数一次元に配列して構成されている。隣接する振動子ユニット間には振動子ユニット配列方向溝7が設けられている。また、各振動子ユニット内において隣接する振動子エレメント間には振動子エレメント間溝6が設けられている。なお、振動子エレメントの形状は、正方形に限定されない。

30

【0036】

図3は、本実施形態における振動子エレメント3単体の上面図を示す。振動子エレメント3は、振動子ユニット配列方向溝7、振動子エレメント間溝6、振動子セル電極間インターフェクト電極8,9,10、振動子セル上部電極11、犠牲層剤除去孔13、下部電極スルーホール電極部14から構成される。振動子セル上部電極11の背面(図面に対して垂直方向)には、キャビティが形成されており、それをキャビティ周縁部12として表している。

【0037】

振動子エレメント3は、複数の振動子セルから構成されており、振動子セルはキャビティの個数に等しく、同図では4つの振動子セルから構成される。また、15はダイシングするためのダイシングラインを示している。

40

【0038】

図4は、図3のAa-Abについての断面図である。この断面において、振動子エレメント3は、上述の通り、30で示される構成単位を振動子セルといふ。メンブレンとはセル30上部を覆っている膜のことをいい、図4では上部電極11、メンブレン上層24、メンブレン下層22で構成される膜のことをいう。このメンブレンは、各振動子セルの両端のメンブレン支持部20で固定された振動膜である。メンブレン支持部20におけるシリコン基板16の表面(凹部の底部分)に、上部電極11と対向するように下部電極19が構成され、その上に誘電体膜27(例えば、SiO₂)が形成されている。

【0039】

50

下部電極 19 には、下部電極 19 とシリコン基板 16 の底面に設けられた信号入出力端子電極パッド 26 とを電気的に導通させるための下部電極スルーホール電極部 14 が設けられている。具体的には、この下部電極スルーホール電極部 14 のホール表面に形成されたインターフェクト配線 191 により下部電極 19 と信号入出力端子電極パッド 26 とは電気的に導通している。

【0040】

シリコン基板 16 の底面表面はシリコン酸化膜 17 で被膜されている。上部電極 11 及び振動子セル電極間インターフェクト電極 10 は、金属膜で構成されている。また、この上部電極は、溝部 6, 7 の側面及び底面に被膜された金属膜に電気的に導通している。

【0041】

接地電極パッド 25 は、上部電極 11 を GND に接続するために、溝 6, 7 の底面に形成した電極をシリコン基板 16 底面に電気的に導通させるためのパッドである。

誘電体膜 27 は、キャビティを挟んだ上部電極 11 と下部電極 19 間の静電容量を増幅させるためのものである。空乏層 18 は、電子あるいは正孔がほとんど存在しない状態になっている層である。

【0042】

なお、キャビティ（空隙部）21 は、メンブレンとメンブレン支持部 20 と下部電極 19 及び誘電体膜 27 とで囲まれた空間のことをいう。なお、メンブレンは、図 5 で後述するように、製造工程上複数のメンブレン膜から構成されている。また、溝部 6, 7 の底部に配設された電極と設置電極パッド 25 との間の「接触抵抗」が限りなく小さく（オームックコンタクト）なる構造となっている。

【0043】

振動子セル 30 の動作について説明すると、上部電極 11 と下部電極 19 の一対の電極に電圧をかけることで電極間が引っ張りあい、電圧を 0 にすると元に戻る。この振動動作によってメンブレンが振動した結果、超音波が発生し、上部電極 11 の上方向に超音波が照射される。

【0044】

図 5 (図 5A, 図 5B, 図 5C) では、本実施形態における静電容量型超音波振動子の製造工程について説明する。

まず、N 型シリコン基板 40 (厚さ約 100 ~ 500 μm) の上表面に酸化膜 (SiO₂) 202 で、マスクする (S1)。マスク形成は、Wet 酸化法により、厚さ約 300 0 ~ 4000 の酸化膜を形成する。そして、フォトリソグラフィー工程で下部電極スルーホール電極部 42 を形成するためのパターンニングを行い、エッティング工程でパターンニングした酸化膜を除去する。

【0045】

次に、ICP - RIE (Inductively Coupled Plasma active Ion Etching : 誘導結合型プラズマ反応性イオンエッティング) を行うことにより、S1 でマスクされていない部分に孔 42 が開く (S2)。

【0046】

次に、空乏層 43 を形成する (S3)。ここでは、まず N 型シリコン基板 40 の底面についても酸化膜 (SiO₂) でマスクし、フォトリソグラフィー工程で空乏層 43 を形成するためのパターンニングを N 型シリコン基板 40 の上下面について行い、エッティング工程でパターンニングした酸化膜を除去する。それから、P 型のイオンを注入して、熱処理を行うことにより、P 型の拡散層を形成する。

【0047】

次に、コンタクト層 (N+) 44 を両面に形成する (S4)。マスク形成工程、フォトリソグラフィー工程、エッティング工程により、コンタクト層 44 を形成する部分以外を SiO₂ でマスクする。それからマスクされていない部分に対して、N 型のイオンを注入して、熱処理を行うことにより、N 型の拡散層を形成する。これをシリコン基板の両面のコンタクト層 (N+) 44 について行う。

10

20

30

40

50

【0048】

次に、電極膜（P_t / T_i）45を両面に形成する（S5）。まず、マスク41を除去した後、電極膜を形成する部分以外をレジスト材でマスクする。その後、スパッタにより電極膜45を形成し、リフトオフ工程でマスクしたレジスト材を除去する。なお、電極の材質はP_t / T_iに限定されず、Au / Cr、Mo, W、リン青銅、Alなどでもよい。

【0049】

次に、誘電体膜を形成する（S6）。マスク形成工程、スパッタ工程、リフトオフ工程を経て誘電体膜（例えば、SrTiO₃）50を形成する。なお、誘電体膜50はSrTiO₃に限定されず、チタン酸バリウムBaTiO₃、チタン酸バリウム・ストロンチウム、五酸化タンタル、酸化ニオブ安定化五酸化タンタル、酸化アルミニウム、または酸化チタンTiO₂等の高誘電率を有する材料を用いてもよい。10

【0050】

次に、メンブレン支持層を形成する（S7）。メンブレン支持部を形成する部分以外をマスクした後、CVDによりSiN層を形成して、マスクを除去する。そうすると、メンブレン支持部が形成されている。

【0051】

次に、S7で形成したメンブレン支持部間に犠牲層としてポリシリコン52を充填する（S8）。なお、本実施形態では、犠牲層にポリシリコンを用いたが、例えばSiO₂等エッチングできる部材であれば特に限定されない。

【0052】

次に、メンブレンを形成する（S9）。まず、犠牲層エッチング用孔54及び溝55となる部分をマスクする。そして、CVDでSiN膜53を形成する。それから、マスクを除去する。そうすると、メンブレン53と犠牲層エッチング用孔54と溝55とが形成されている。20

【0053】

次に、エッチングにより犠牲層52を除去する（S10）。本実施形態ではポリSiを犠牲層に用いているので、エッチャーレジストとしてXeF₂を用いてエッチングして、犠牲層を犠牲層エッチング用孔54から除去する。そうすると、キャビティ56及び溝55が形成されている。

【0054】

次に、犠牲層エッチング用孔54を塞ぐ（S11）。まず、溝55の底部分（コンタクト電極）をマスクし、CVDを用いてエレメント上面全体にSiN膜を形成する。それから、マスクを除去して、溝55の底部分（コンタクト電極）を露出させる。30

【0055】

最後に、図3に示したように、振動子セル電極間インターネクト電極8, 9, 10、振動子セル上部電極11、振動子ユニット配列方向溝7の底部の電極、振動子エレメント間溝6の底部の電極以外をマスクし、スパッタリング、リフトオフを経て、電極膜（P_t / T_i）61を振動子エレメント上面全体に形成する（S12）ことにより、振動子エレメント3が完成する。

【0056】

なお、本実施形態において、電極膜（及びコンタクト層）の形成、すなわち溝内にある電極を形成する処理（導体化処理）では、イオン注入もしくはCVD（Chemical Vapor Deposition：化学気相成長方法）と拡散処理、またはPVD（Physical Vapor Deposition：物理気相成長法）により行われる。

【0057】

以上より、溝部分に接地電極を形成することで、別途接地電極のための領域を振動子エレメント内に設ける必要が無く、振動子エレメントに占める超音波出力領域の面積比率を低下させることはない。また、溝部を設けているために隣接するエレメント間のクロストークの影響を抑制することができる。4050

【0058】

なお、本実施形態では一例としてラジアルタイプの静電容量型超音波振動子を用いたが、これに限定されず、コンベックスタイプでもリニアタイプでもよい。

<第2の実施形態>

本実施形態では、振動子エレメントに設けた溝の形状のバリエーションについて説明する。

【0059】

図6は、本実施形態における溝の形状のバリエーションの一例（その1）を示す。70及び71は溝部を示している。76はシリコン基板を示している。72（72a, 72b, 72c）はシリコン基板76上面側のコンタクト電極を示している。73（73a, 73b, 73c）はコンタクト電極72（72a, 72b, 72c）周辺に形成されたコンタクト層を示している。74はシリコン基板76下面側のコンタクト電極を示している。75はコンタクト電極74周辺に形成されたコンタクト層を示している。77及び78はSiN層を示している。79は電極膜を示している。

10

【0060】

70は、溝部をテーパー形状にして開口部を底部より広くした場合を示している。このようにすることにより、孔径がある大きさ以上の場合は、スパッタリングを用いて電極を成膜することが可能となる。また、溝の側面が垂直な場合と比較して、スパッタで電極膜が付着しやすく、より厚く成膜することができる。それにより、配線の信頼性が向上する。

20

【0061】

71は、ボッシュ（Bosh）プロセスにより溝部側面の表面に凹凸を形成した場合を示している。ボッシュプロセスとは、反応ガスにC₄F₈とSF₆を用い、交互に切り替えエッチングとバッシベーション（化学反応を起こさないように表面に保護膜を付与する）工程を繰り返すプロセスのことである。高アスペクト比の加工が可能になる。ボッシュプロセスで溝部を形成する場合、バッシベーションとエッチングのタイミングを変化させ、テーパーや凹凸を形成することが可能となる。

【0062】

通常のボッシュプロセスでできる波線状の凹凸は数～数十nmオーダーである。しかしながら、本実施形態では、密着強度を上げるために、溝側壁にサブμmオーダー以上の凹凸を設けてある。この凹凸により、付与するメンブレンと同材質のSiNや上部電極と繋がる導体薄膜の密着性が向上する。そして、後述する超音波減衰材料の密着性も向上し、精密裁断などにより裁断する時の強度向上に繋がる。

30

【0063】

このように、ボッシュプロセスを用いて溝部側面の表面に凹凸を形成することで、表面積が大きくなり、その後の工程で付与される電極膜やSiN膜が剥離しにくくなる。また、溝部の底部にあるコンタクト電極72（72a, 72b, 72c）のGNDは、シリコン基板76を介してコンタクト電極74から接続される。

【0064】

図6の左側のトレンチ部分は開口部より底部の方が広い形状となっている場合の例を示している。このように、溝の形状は、どのような形状でも構わない。

40

図7は、本実施形態における溝の形状のバリエーションの一例（その2）を示す。同図は、図6より溝の底部をシリコン基板76内部まで掘り下げた場合を示す。シリコン基板76までエッチングした後に、コンタクト層73を形成してそれを下地として電極を成膜したものである。すなわち、コンタクト層形成後に、SiN（犠牲層の除去する穴を塞ぐ）の成膜をCVDで行い、コンタクト層表面が自然酸化等で抵抗を持たないように、メンブレンと繋がっている電極79を成膜する前に、耐蝕性の強い電極材を下地電極として成膜する。

【0065】

このように、コンタクト電極72（72a, 72b, 72c）とコンタクト電極74と

50

の距離が短くなり、電気的損失を減少させることができるので、配線の信頼性が向上する。

【0066】

また、ドライエッチングなので、機械的強度に問題がない限り、波線状にエッチングすることも可能である。つまり、通常の溝形成（裁断も同様）はダイシングソー（精密裁断機）で行われるが、そのため、直線状にしか溝形成はできない。しかし、ICP-RIEなどのドライエッチングでは波線をはじめ任意の形状で溝形成が可能となる。

【0067】

また、溝表面が不定形では、長さに差があるため一定の共振が起こりにくくなるという観点から、クロストーク減少の効果がある。また、基板背面への接地電極の取り出しを容易にする効果もあり。10

【0068】

また、シリコン基板中にも溝がある構成にすることにより、クロストーク減少の効果がある。すなわち、メンブレンの屈曲振動によって超音波を送受信するが、その屈曲振動は、ラム波またはストンリー波等による振動で隣接したエレメント間でクロストークが発生する。また、屈曲振動はメンブレン支持部に反作用的に縦振動応力を伝達する。この振動はメンブレン支持部の付け根からシリコン基板表面に到達し、シリコン基板表面に沿って伝播し、同じ経路を逆にたどって隣のエレメントに伝播しクロストークの原因になる。このようなクロストークの発生を減少することができる。

【0069】

図8は、本実施形態における溝の形状のバリエーションの一例（その3）を示す。同図は、シリコン基板76の両面のコンタクト層を接合した場合を示す。同図のように、シリコン基板76の厚さが薄い場合、または（GND用）溝をシリコン基板にエッチングした後、コンタクト層73, 75を形成し、拡散させ、コンタクト層を形成すると、薄いコンタクト層同士を接続することができる。このようにすることにより、抵抗値の低い領域がコンタクト電極72とコンタクト電極74間で形成されるので電気的に導通しやすく、電気的損失を減少させることができるので、配線の信頼性が向上する。20

【0070】

<第3の実施形態>

本実施形態では、静電容量型振動子エレメントのバリエーションについて説明する。

図9は、本実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例（その1）を示す。30

【0071】

80は溝部を示している。86はシリコン基板を示している。82はシリコン基板86上面側のコンタクト電極を示している。83はコンタクト電極82周辺に形成されたコンタクト層を示している。84はシリコン基板86下面側のコンタクト電極を示している。85はコンタクト電極84周辺に形成されたコンタクト層を示している。87及び88はSiN層を示している。89は電極膜を示している。90はSiO₂膜を示している。81は下部電極スルーホール電極部を示している。

【0072】

同図は、シリコン基板86の下面側のコンタクト電極付近もエッチングされている場合を示す。これは、図5のS1の段階で、シリコン基板下面にもSiO₂でマスクし、ウェットエッチングにより、電極コンタクト部をエッチングして、凹部形状となるようにする。このようにすることにより、両面のコンタクト電極（82, 84）間の距離がより短くなり、電気的損失を減少させることができるので、配線の信頼性が向上する。40

【0073】

また、図7と同様に、シリコン基板86に溝部が侵食した構成を採用することにより、クロストーク減少の効果がある。つまり、メンブレンの屈曲振動によって超音波を送受信するが、その屈曲振動は、ラム波またはストンリー波等による振動で隣接したエレメント間にクロストークが発生する。また、屈曲振動はメンブレン支持部に反作用的に縦振動応

10

20

30

40

50

力を伝達する。この振動はメンブレン支持部の付け根からシリコン基板表面に到達し、シリコン基板表面に沿って伝播し、同じ経路を逆にたどって隣のエレメントに伝播しクロストークの原因になる。シリコン基板 8 6 に溝部が侵食した構成を採用することにより、このようなクロストークを減少させることができる。また、基板背面への接地電極の取り出しを容易にする効果もある。

【0074】

なお、空乏層の形成の変わりに、 SiO_2 のWet酸化膜を利用してよい。これはWet酸化の方が、緻密な膜が得られるからである。また溝を形成後に、N型シリコン基板であれば溝内に N^+ をドープし、加熱により拡散処理を行うことにより、コンタクト層(N^+)を形成してもよい。また、溝の形状は、溝底部のうち一部分がさらに深くなっている形状でもよいし、またシリコン基板下面まで孔が到達している形状でも良い。10

【0075】

図10は、本実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その2)を示す。同図は、シリコン基板86をエッチングすることによりキャビティ91を形成した場合を示す。この場合、シリコン基板86がメンブレン支持部としても機能する。

【0076】

まず、TMAH(Tetramethyl Ammonium Hydroxide)を使って、 Si の異方性エッチングを実施する。これにより、シリコン基板86の上面側に所定の深さのキャビティ91及び溝80を形成し、下面側に凹部95を形成する。20

【0077】

次に、ICP-RIEで貫通孔81を形成する。その後、酸化膜90をWet酸化で成膜する(空乏層の代わりとして用いている)。次に、下部電極92(Pt/Ti)を成膜して、貫通孔81の側壁へ導体付与する。

【0078】

次に、誘電体93を下部電極92の上面に成膜し、熱処理を行う。その後、キャビティ91に犠牲層を形成し、その上から SiN メンブレン87を成膜する。成膜したメンブレンに孔94を開け、犠牲層をエッチングして除去する。その後、 SiN にて犠牲層除去用の孔94を埋める(88)。その上から上部電極(89)を成膜する。

【0079】

このようにすることで、メンブレン支持部を形成する工程を別途設ける必要が無く、工程数を減らすことができる。

図11は、本実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その3)を示す。図12は、本実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その4)を示す。図11及び図12は、溝部80を樹脂100で充填した場合を示す。

【0080】

図11と図12の相違は、シリコン基板86の下面のコンタクト電極が凹部形状になっているか否かである。溝部分80に樹脂100が充填されていないと、振動子内に横波定在波(不要振動)が励起されることがあり、良好な超音波特性が得ることができない。そこで、溝部分80に樹脂100を充填する。材質としては、不要超音波による振動を減衰させるために、タンクステン微粉末やガラスバブルなどの粉末をシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などに混合した柔軟性がある複合樹脂を超音波減衰材料として用いる。このようにすることにより、不要振動を抑制することができる。40

【0081】

なお、図1~図4の溝部(上方から振動子エレメントを見た場合に縦横に溝が形成されている)のうち、コンベックス、ラジアルのように振動子の配列が曲率を持つタイプは少なくとも、片面側(例えば、上面側)をダイシングする。この際に、充填樹脂が存在すると、応力が低減され電極の剥離、チッピングなどが減少する。このように、配線の信頼性が向上すると共に、チッピングが減少することで、キャビティと溝との間を短くすること50

ができるので設計上有効部分が増加し、単位面積あたりの音圧增加、つまりは感度向上、サイズの縮小化に繋がる。

【0082】

図13は、本実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例（その5）を示す。同図は、振動子エレメントをFPC（フレキシブルプリント基板）に導電性樹脂101を用いて接合した場合を示す図である。なお、導電性樹脂101の代わりに、ACF（Anisotropic Conductive Film：異方性導電シート）、またはAuや半田などのボールバンプを利用してよい。また、シリコン基板86の下面とFPC102の間の空隙部104は、樹脂を充填しても良い。

【0083】

なお、溝部80には樹脂を充填せずダイシングしてダイシング溝105を形成することも可能であるし、溝部80に樹脂を充填してダイシングしてダイシング溝105を形成することも可能である。ダイシング後、湾曲させてトランステューサを形成した後、減衰の大きな樹脂材料を充填しても良い。裁断溝の深度は、コンベックスタイプやラジアルタイプのように振動子エレメントを湾曲させるタイプのものであれば、導電性樹脂101まで裁断する必要があるが、リニアタイプなどの湾曲させないものは、少なくともシリコン基板86がダイシングされれば良い。曲また、シリコンのFPC側の電極部が凹状や、穴状になっていると、位置決め機能が得られると共に、接着表面積の拡大による接続の機械的強度が向上し、信頼性の高い振動子が作製できる。

【0084】

なお、シリコン基板を貫通させる場合、レーザービームを用いても良い。レーザービームを用いることにより、ドライエッチング同様に、任意の形状で溝切り、裁断が可能となる。そのため、クロストーク低減の効果や、波線状にすることで電極の接触面積が増え密着強度が向上する。また、エレメントを任意の形状とできるため、セル配置を任意に行え、高密度化（エレメント内に占めるセル面積が多いなど）が達成できる。内視鏡のように限られた空間内で、高感度化を実現するには重要となる。

【0085】

なお、通常、振動子エレメント上方から見た場合、図3に示すように溝は直線状であるが、フォトリソと、エッティングを用いると曲線状の溝を形成することも可能である。この例を図14に示す。

【0086】

図14は、本実施形態における振動子エレメント3を上面から見たときに曲線状の溝を形成する場合の一例を示す図である。図14(a)は、振動子エレメント3を囲む溝111（横方向の溝111a、縦方向の溝111bを曲線状にし、直線状にダイシング（ダイシングライン110）した場合の一例を示す。このように、振動子エレメントの全周囲が波線状の溝形状をもってもよい。

【0087】

図14(b)は、振動子エレメントを囲む溝111a、111bを曲線状にし、曲線状にダイシング（ダイシングライン110）した場合の一例を示す。レーザーダイシングを用いれば、このように曲線状の溝に沿ってダイシングが可能となる。

【0088】

図14(c)は、振動子エレメントを囲む溝のうち、縦方向の溝111bを直線状、横方向の溝111aを曲線状にし、直線状にダイシング（ダイシングライン110）した場合の一例を示す。112は接地電極である。このように、部分的に波線状の溝構造をもつてもよい。

【0089】

図14の例以外にも、溝の形状及びダイシングの形状は、当然、矩形波状や鋸波であってもその他不定形なものであっても構わない。

直線状の溝では、共振が激しくなり、定在波も起こりやすくなるが、直線状でない場合には不要振動は打ち消し合って弱まる。そのために、クロストークが減少し、そして、S

10

20

30

40

50

/ N 比が向上、高画質な画像にすることができる。なお、ダイシング位置や、充填する減衰樹脂も曲線状のものを採用することで、同様な機能・効果を持たせることができる。

【図面の簡単な説明】

【0090】

【図1】第1の実施形態における静電容量型ラジアル走査アレイ超音波振動子を示す図である。

【図2】第1の実施形態における振動子ユニット2単体の上面図を示す図である。

【図3】第1の実施形態における振動子エレメント3単体の上面図を示す図である。

【図4】図3のAa - Abについての断面図である。

【図5A】第1の実施形態における静電容量型超音波振動子の製造工程を示す図(その1)である。

【図5B】第1の実施形態における静電容量型超音波振動子の製造工程を示す図(その2)である。

【図5C】第1の実施形態における静電容量型超音波振動子の製造工程を示す図(その3)である。

【図6】第2の実施形態における溝の形状のバリエーションの一例(その1)を示す図である。

【図7】第2の実施形態における溝の形状のバリエーションの一例(その2)を示す図である。

【図8】第2の実施形態における溝の形状のバリエーションの一例(その3)を示す図である。

【図9】第3の実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その1)を示す図である。

【図10】第3の実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その2)を示す図である。

【図11】第3の実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その3)を示す図である。

【図12】第3の実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その4)を示す図である。

【図13】第3の実施形態における静電容量型振動子エレメントのバリエーションの一例(その5)を示す図である。

【図14】第3の実施形態における振動子エレメント3を上面から見たときに曲線状の溝を形成する場合の一例を示す図である。

【図15】従来のc-MUTを示す図である。

【符号の説明】

【0091】

1 静電容量型ラジアル走査アレイ超音波振動子

2 振動子ユニット

3 振動子エレメント

4 制御回路ユニット

5 配線用FPC

6 振動子エレメント間溝

7 振動子ユニット配列方向溝

8, 9, 10 振動子セル電極間インターフェクト電極

11 上部電極

12 キャビティ周縁部

13 犠牲層剤除去孔

14 下部電極スルーホール電極部

15 ダイシングライン

16 シリコン基板

10

20

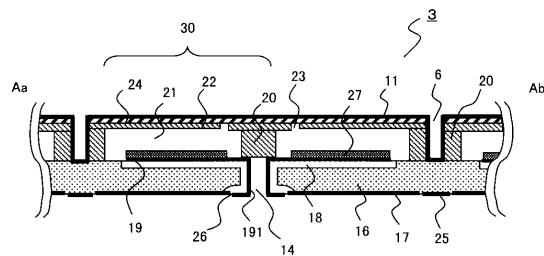
30

40

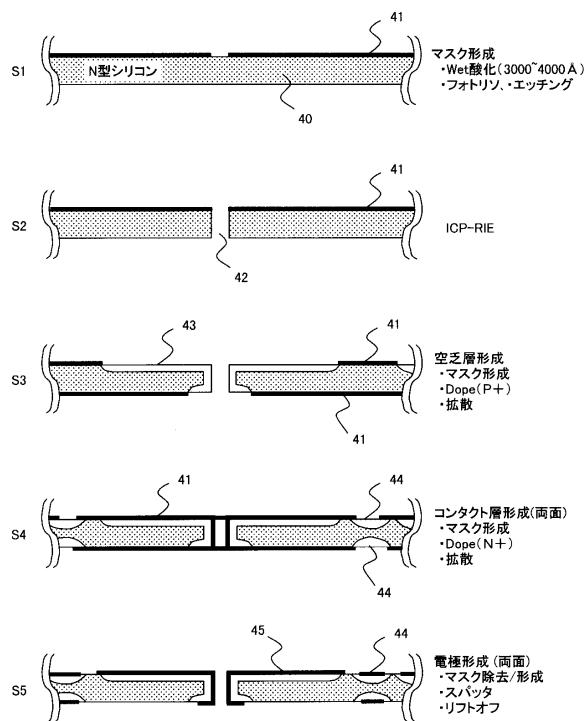
50

1 7	シリコン酸化膜	
1 8	空乏層	
1 9	下部電極	
1 9 1	インターフェクト配線	
2 0	メンブレン支持部	
2 1	キャビティ	
2 2	メンブレン下層(キャビティ形成用被覆膜)	
2 3	犠牲層除去孔	
2 4	メンブレン上層(犠牲層除去孔遮蔽膜)	
2 5	接地電極パッド	10
2 6	信号入出力端子電極パッド	
2 7	誘電体膜	
3 0	振動子セル	
7 0 , 7 1	溝部	
7 2 (7 2 a , 7 2 b , 7 2 c)	コンタクト電極	
7 3 (7 3 a , 7 3 b , 7 3 c)	コンタクト層	
7 4	コンタクト電極	
7 5	コンタクト層	
7 7 , 7 8	SiN層	
7 9	電極膜	20
8 0	溝部	
8 1	下部電極スルーホール電極部	
8 2	コンタクト電極	
8 3	コンタクト層	
8 4	コンタクト電極	
8 5	コンタクト層	
8 6	シリコン基板	
8 7 , 8 8	SiN層	
8 9	電極膜	
9 0	SiO ₂ 膜	30

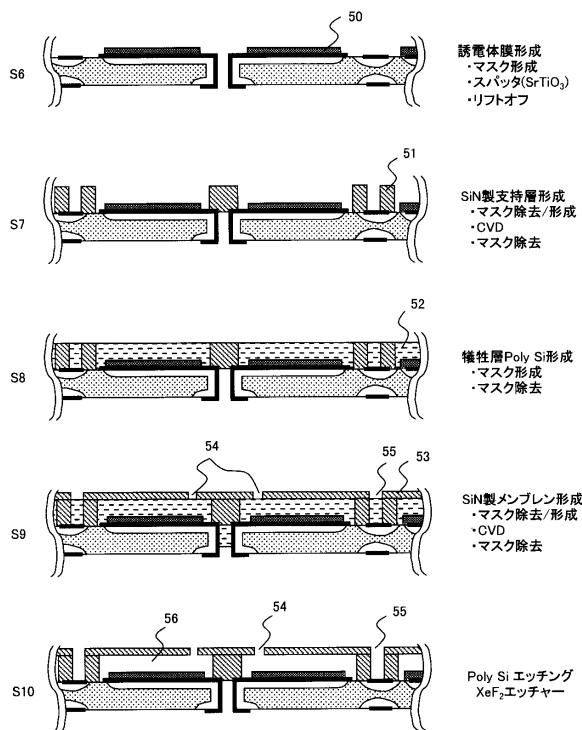
【図4】



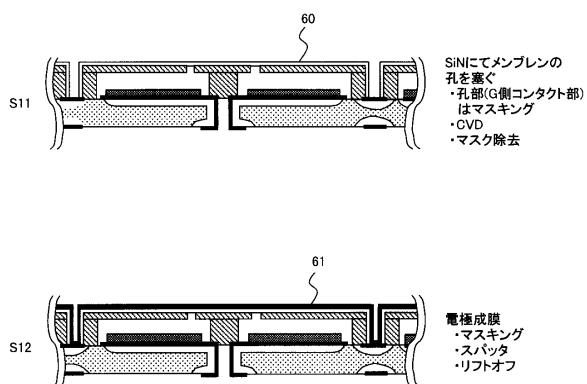
【図5 A】



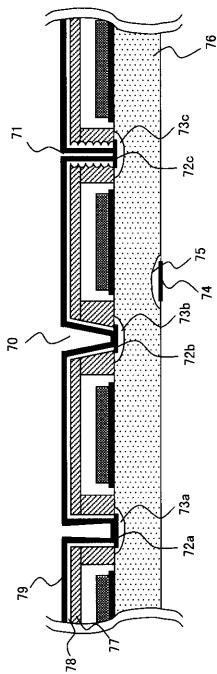
【図5 B】



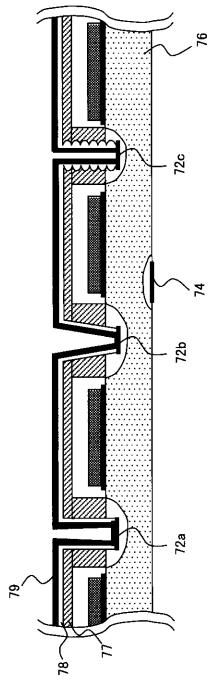
【図5 C】



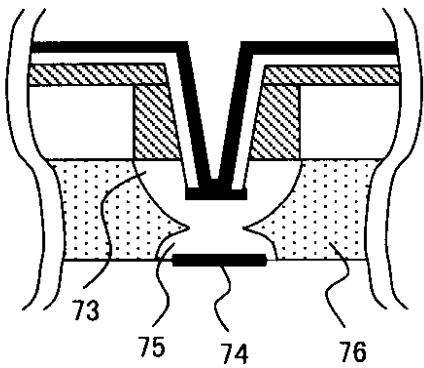
【図6】



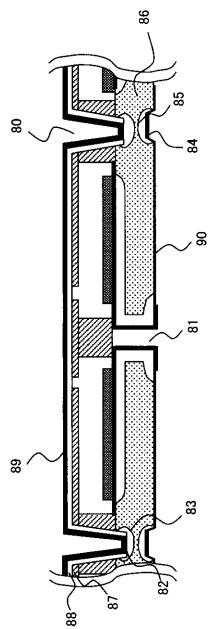
【図7】



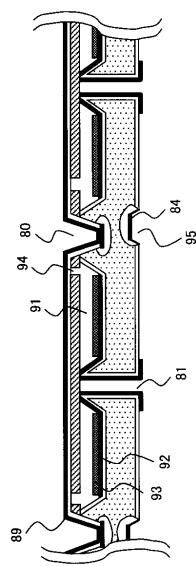
【図8】



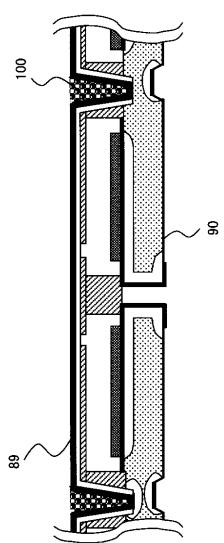
【図9】



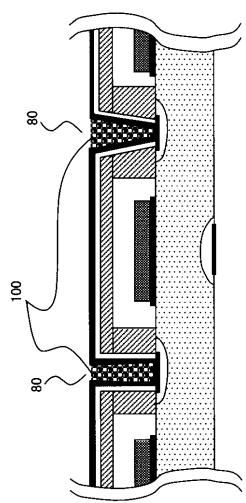
【図10】



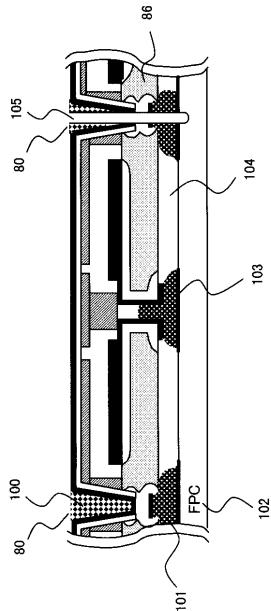
【図11】



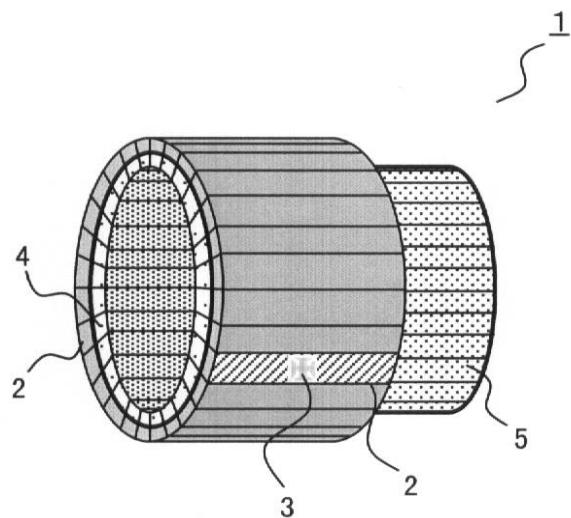
【図12】



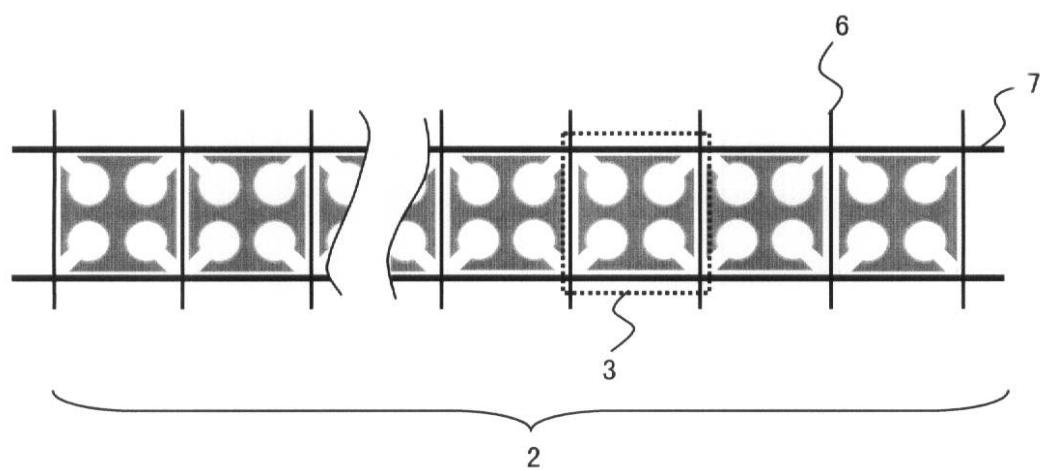
【図13】



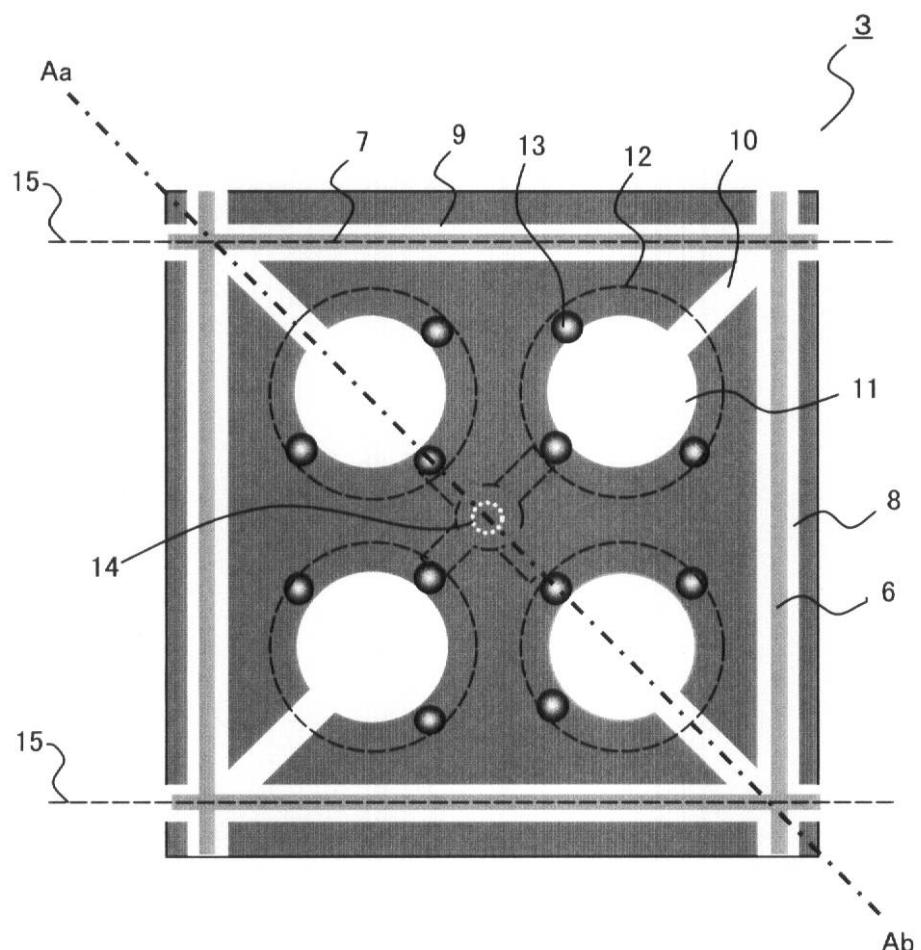
【図1】



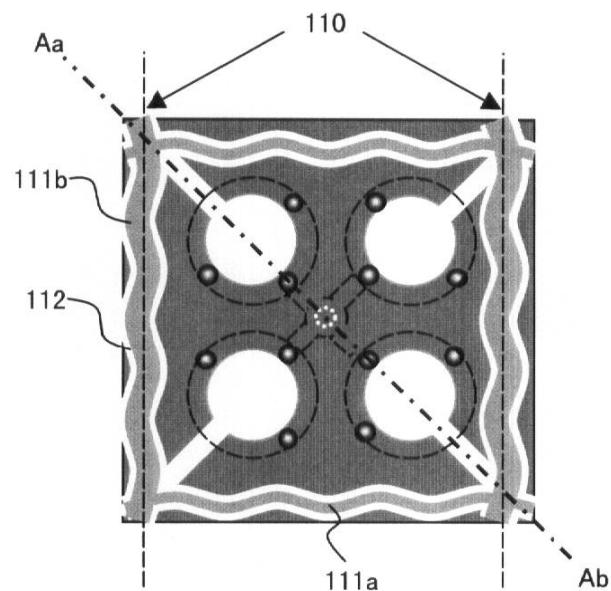
【図2】



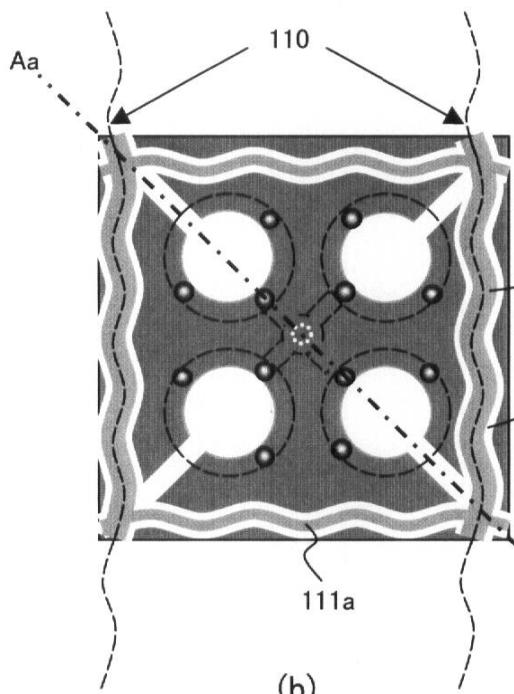
【図3】



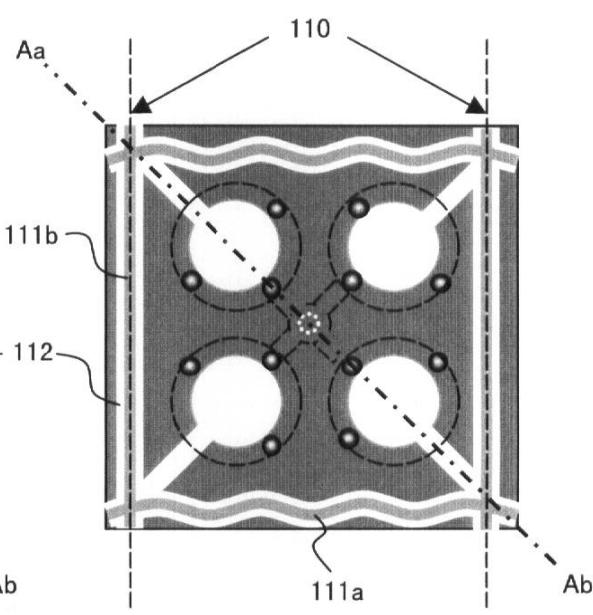
【図14】



(a)

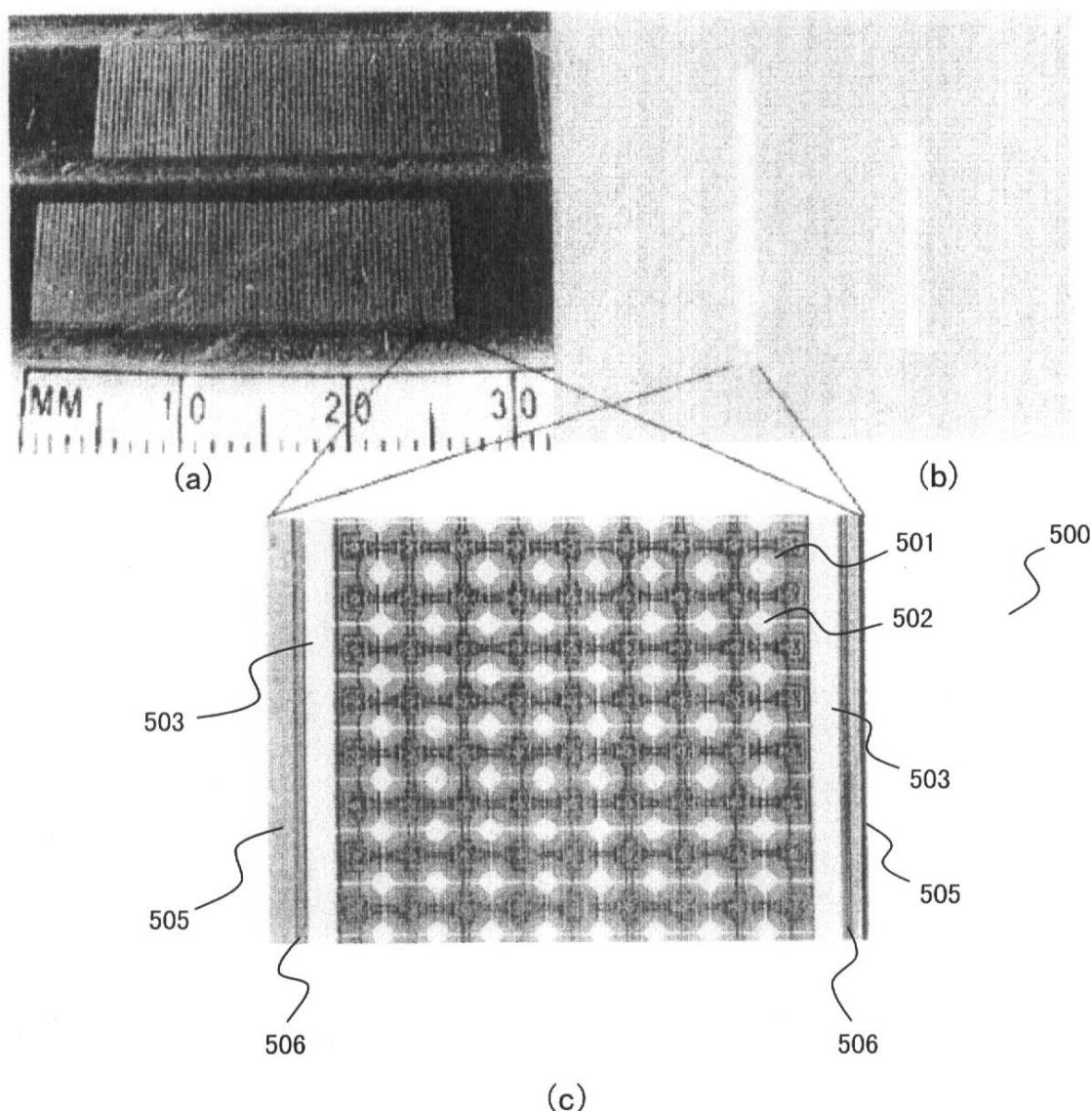


(b)



(c)

【図15】



フロントページの続き

審査官 後藤 順也

(56)参考文献 特表2003-527947(JP,A)

Yongli Huang etal., Fabricating Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers With Wafer-Bonding Technology, J Microelectromechanical Syst, 2003年 4月, vol.12, no.2, p.128-137

Utkan Demirci etal., Forward-Viewing CMUT Arrays for Medical Imaging, IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 2004年 7月, vol.51, no.7, p.886-894

Mills D.M, etal., Real-time in-vivo imaging with capacitive micromachined ultrasound transducer (cMUT) linear arrays, Proc IEEE Ultrason Symp, 2003年 8月, vol.1, p.568-571

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 6 1 B 8 / 0 0
J S T P l u s (J D r e a m I I)

专利名称(译)	电容式超声换能器及其制造方法		
公开(公告)号	JP4624763B2	公开(公告)日	2011-02-02
申请号	JP2004312172	申请日	2004-10-27
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
当前申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	若林勝裕 安達日出夫 根本清志		
发明人	若林 勝裕 安達 日出夫 根本 清志		
IPC分类号	A61B8/00 H04R19/00		
FI分类号	A61B8/00 H04R19/00.330 A61B8/12 G01N29/24.502		
F-TERM分类号	2G047/AA12 2G047/AC13 2G047/CA01 2G047/DB02 2G047/EA15 2G047/GB02 2G047/GB18 2G047 /GB21 2G047/GB32 4C601/BB06 4C601/BB24 4C601/EE13 4C601/FE03 4C601/FE04 4C601/GB10 4C601/GB41 4C601/GB48 5D019/AA21 5D019/AA25 5D019/DD01 5D019/HH01		
其他公开文献	JP2006122188A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种电容式超声波振动器，其在振动器元件的两端具有凹槽部分，而不会降低单元区域与整个区域的比率，并且不会减小所产生的超声波的输出。ŽSOLUTION：电容式超声波振动器由硅基板，作为输入/输出驱动控制信号的最小单元的振动器元件，以及通过电极垫连接到硅基板背面的柔性印刷基板组成。振动器元件由振动器单元组成，每个振动器单元包括设置在硅衬底的上表面上的第一电极，通过对第一电极设置的第二电极，其间具有规定的间隙，以及支撑第二电极的膜。凹槽部分设置在相邻的振动器元件之间，并且导电膜形成在凹槽部分中。Ž

(4)

